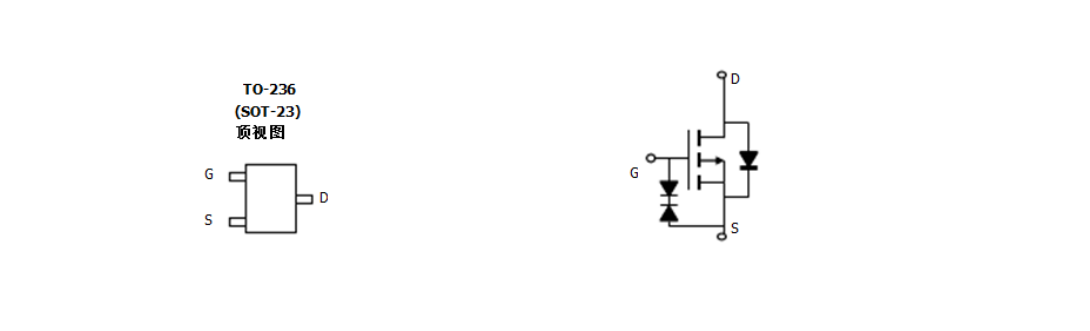
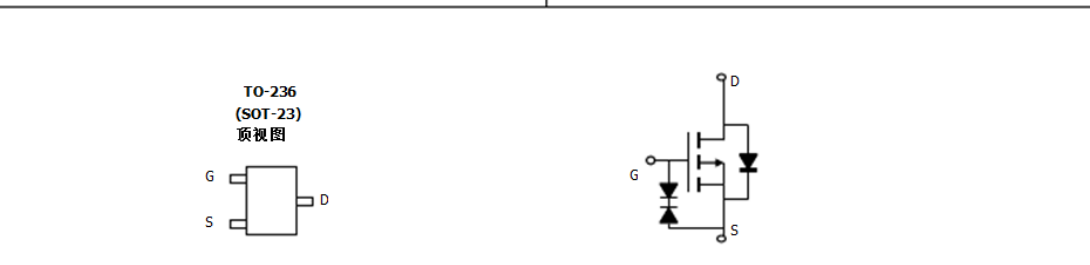




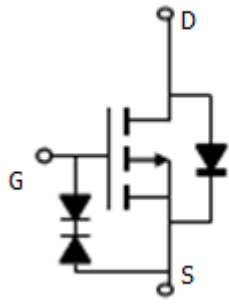
AO3419, AO3419L (绿色产品)
P沟道增强型场效应晶体管

<p>概述</p> <p>该AO3419采用先进的沟槽技术提供了优秀的研发 $R_{DS(on)}$ 低栅极电荷和操作与栅极电压低至2.5V。这装置适合于用作负载开关或以PWM应用程序。这是ESD保护。AO3419L (绿色产品) 的无铅封装提供。</p>	<p>特点</p> <p>$V_{DS} (V) = -20V$ $I_D = -3.5 A$ $R_{DS(on)} < 75m\Omega (V_{GS} = -10V)$ $R_{DS(on)} < 95m\Omega (V_{GS} = -4.5V)$ $R_{DS(on)} < 145m\Omega (V_{GS} = -2.5V)$ ESD额定值: 2000V HBM</p>
--	---



绝对最大额定值		A = 25 °C 除非另有说明	
参数	符号	最大	单位
漏源电压	V_{DS}	-20	V
栅源电压	V_{GS}	± 12	V
连续漏极	I_D	-3.5	A
当前 ^A		$T_A = 25^\circ C$	
		-2.8	
漏电流脉冲	I_{DM}	-15	
功耗 ^A	P_D	1.4	W
		$T_A = 25^\circ C$	
		0.9	
结温和存储温度范围	$T_J, T_{存储}$	-55到150	°C

热特性					
参数	符号	典型值	最大	单位	
最大结点到环境 ^A	$R_{\theta JA}$	稳态	65	90	°C / W
			$t \leq 10s$		
最大结点到环境 ^A	$R_{\theta JA}$	稳态	85	125	°C / W
			稳态		
最大结对铅 ^C	$R_{\theta AL}$	稳态	43	60	°C / W



TO-236
(SOT-23)
顶视图

